

ハイパワーGaAs SPDTスイッチ NJG1516KC1のサンプル配布開始

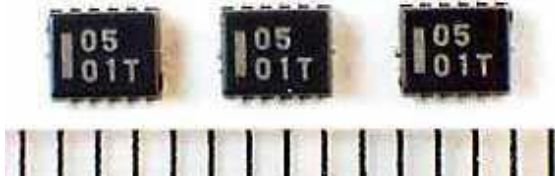
<概要>

新日本無線では、ハイパワーGaAsSPDT(シングル・ポール・ダブル・スロー)スイッチ NJG1516KC1の開発を完了し、サンプル配布が可能となりましたのでお知らせいたします。

NJG1516KC1は、高電力(通過電力:36dBm typ.)、低ひずみ(IIP3=62dBm typ. @V_{DD}=3.0V @f=900MHz)を実現したハイパワーSPDTスイッチで、GSM方式携帯電話(2W出力=33dBm)のアンテナ切り替えスイッチとして最適です。さらに低損失、高アイソレーション、低切替電流、低電圧正電源動作、超小型/薄型パッケージ搭載(FLP10-C1 2.8×3.0×0.75mm)など携帯電話に最適な特徴を有しております。

(2000年12月18日)

<開発製品一覧>

製品名	機能	応用	外形
NJG1516KC1	ハイパワーGaAs SPDTスイッチ	GSM方式携帯電話	FLP10-C1
			

<製品の機能および特徴の概要>

- ・低電圧正電源動作 +2.7V min.
- ・0.2dB 圧縮時入力電力 36dBm typ. @f=2GHz, V_{CTL}=3V
- ・低挿入損失 0.4dB typ. @f=1GHz, Pin=31dBm, V_{CTL}=3V
0.4dB typ. @f=1GHz, Pin=34.5dBm, V_{CTL}=3.5V
0.7dB typ. @f=2GHz, Pin=31.5dBm, V_{CTL}=3V
- ・高アイソレーション 27dB typ. @f=1GHz, Pin=34.5dBm, V_{CTL}=3V
25dB typ. @f=2GHz, Pin=31.5dBm, V_{CTL}=3V
- ・低切替電流 38μA typ. @f=2GHz, Pin=34.5dBm, V_{CTL}=3V
- ・超小型&超薄型パッケージ FLP10-C1 (Mount Size: 2.8×3.0×0.75mm)

<生産予定/サンプル価格>

弊社では、NJG1516KC1のサンプル配布を2000年12月より、量産を2001年1月より開始し、生産は月産10万個で立ち上げる予定です。なお、サンプル価格は下記の通りです。

サンプル価格

製品名	機能	サンプル価格
NJG1516KC1	ハイパワーGaAs SPDTスイッチ	@¥150